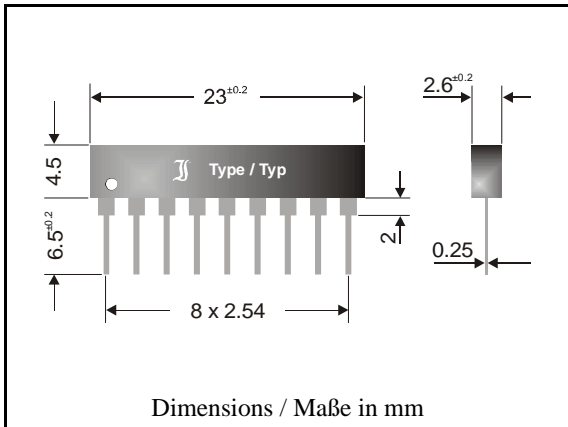


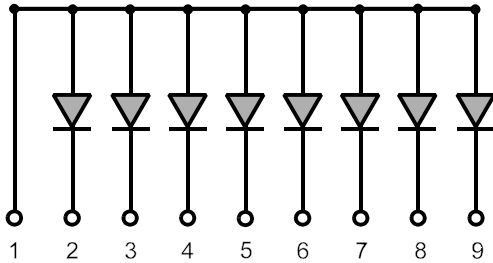
**Fast Switching Rectifier Arrays**

**Schnelle Gleichrichter Sätze**

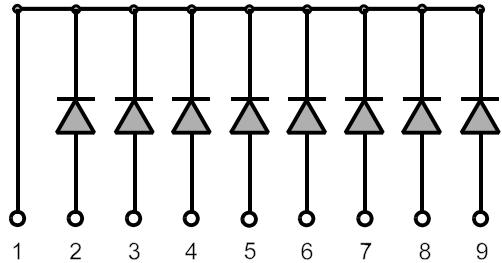
Version 2004-10-01



Nominal power dissipation 1.2 W  
 Nenn-Verlustleistung  
 Repetitive peak reverse voltage 100...400 V  
 Periodische Spitzensperrensorgung  
 9 Pin-Plastic case 23 x 2.6 x 4.5 [mm]  
 9 Pin-Kunststoffgehäuse  
 Weight approx. – Gewicht ca. 0.6 g  
 Standard packaging: bulk  
 Standard Lieferform: lose im Karton



"DA811A...8110A": com. anodes / gem. Anoden



"DA811K...8110K" : com. cathodes / gem. Kathoden

**Maximum ratings**

**Grenzwerte**

| Type<br>Typ | Repetitive peak reverse voltage<br>Periodische Spitzensperrensorgung<br>$V_{RRM}$ [V] | Surge peak reverse voltage<br>Stoßspitzensperrensorgung<br>$V_{RSM}$ [V] |
|-------------|---|--|
| DAF811A/K   | 100   | 120  |
| DAF814A/K   | 400   | 480  |

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| Max. average forward rectified current, R-load,<br>for one diode operation only<br>per diode for simultaneous operation | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | $I_{FAV}$ 600 mA <sup>1)</sup><br>$I_{FAV}$ 150 mA <sup>1)</sup> |
| Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last,<br>für eine einzelne Diode<br>pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb         | $T_U = 25^\circ\text{C}$ | $I_{FAV}$ 600 mA <sup>1)</sup><br>$I_{FAV}$ 150 mA <sup>1)</sup> |
| Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave<br>Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwell                             | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | $I_{FSM}$ 30 A   |

<sup>1)</sup> Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
 Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

|   |                          |                  |                     |
|---|--------------------------|------------------|---------------------|
| Max. power dissipation – Verlustleistung                | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | $P_{\text{tot}}$ | 1.2 W <sup>1)</sup> |
| Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur |                          | $T_j$            | - 50...+150°C       |
| Storage temperature – Lagerungstemperatur               |                          | $T_S$            | - 50...+150°C       |

**Characteristics****Kennwerte**

|   |   |   |                  |  |
|---|---|---|------------------|--|
| Forward voltage<br>Durchlaßspannung   | $T_j = 25^\circ\text{C}$                              | $I_F = 1 \text{ A}$   | $V_F$            | < 1.3 V                                  |
| Leakage current<br>Sperrstrom   | $T_j = 25^\circ\text{C}$<br>$T_j = 100^\circ\text{C}$ | $V_R = V_{RRM}$<br>$V_R = V_{RRM}$  | $I_R$<br>$I_R$   | < 10 $\mu\text{A}$<br>< 90 $\mu\text{A}$ |
| Reverse recovery time<br>Sperrverzug  |   | $I_F = 10 \text{ mA}$ through/über<br>$I_R = 10 \text{ mA}$ to/auf $I_R = 1 \text{ mA}$ | $t_{rr}$         | < 350 ns                                 |
| Thermal resistance junction to ambient air<br>Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft |   |   | $R_{\text{thA}}$ | < 85 K/W <sup>1)</sup>                   |

<sup>1)</sup> Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten